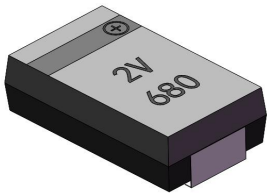


表面贴装型

SD大容量系列



产品特点

- 高电压（25V，max）
- 大容量（高度 2.8mm）
- 耐纹波电流能力好（8500mA，max）
- 环保（符合无卤、RoHS和REACH规定）

产品应用

- 服务器
- 5G通信基站
- 区块链
- 人工智能
- 笔记本电脑/显卡
- 无线充电器
- 固态硬盘
- 无人机
- 北斗卫星
- 物联网
- 安装监控
- 新能源汽车及其他

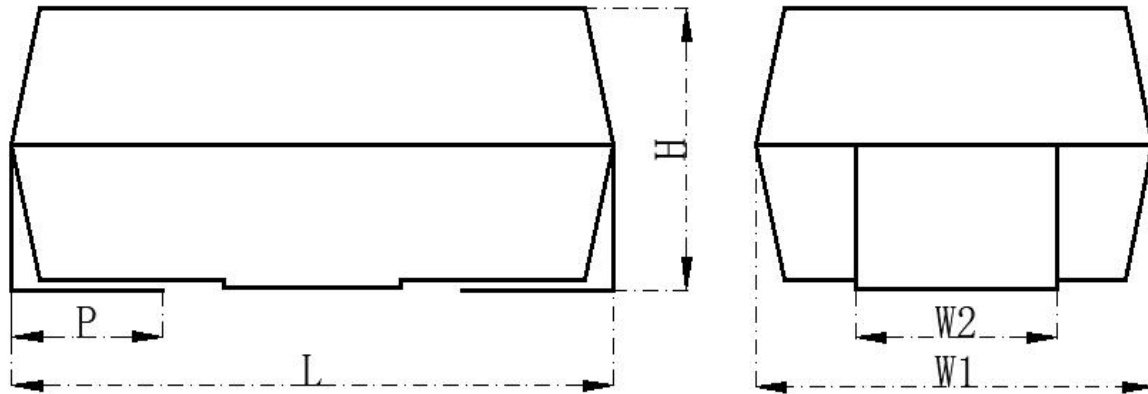
产品规格

系列	SD	
类别温度	-55℃~105℃	
额定电压	2V~25V	
静电容量范围(120Hz,20℃)	100μF~820μF	
漏电流（LC）	2V~6.3V: ≤0.1CV, 10V~25V: ≤0.3CV（额定电压，2分钟）	
静电容量容差	K档(-10%~+10%), M档(-20%~+20%), Y档(-35%~+10%) 或定制其他档位	
损耗角正切（tgδ）	≤ 0.06 (频率：120Hz，温度：20℃)	
浪涌电压 (V)	2V~16V:1.25*V <sub>R</sub> , 20V~25V:1.15*V <sub>R</sub> （15℃~35℃）	
耐久性	温度：105 ±3℃	外观：无明显损伤
	施加电压：额定电压(DC)	容量变化：初始值的-20%~+20%
	测试时间：2000h	损耗角正切 (tgδ): ≤0.12
	恢复时间：1~2h	漏电流：≤规定值
高温高湿	温度：60 ±2℃	外观：无明显损伤
	湿度：90 <sup>+2</sup> <sub>-3</sub> %RH	容量变化：初始值的-20%~+70%（2V~2.5V）， 初始值的-20%~+60%（4V~25V）
	空载，测试时间：500h	损耗角正切(tgδ): ≤0.12
	恢复时间：1~2h	漏电流：≤规定值的300%

# 叠层导电高分子铝电容器（SD系列）



## 产品尺寸



系列	L (mm)±0.4	W1 (mm)±0.3	H (mm)±0.2	P (mm)±0.2	W2 (mm)±0.1
SD	7.3	4.3	2.8	1.3	2.4

## 特性一览表

产品编号	额定电压 (V)	容量 (μF) *1	损耗 *2	ESR (mΩ) *3	纹波电流 (mA) *4	漏电流 (μA) *5
SD0D561MR009A0	2	560	0.06	9	6300	112
SD0D681MR006A0		680	0.06	6	7500	136
SD0D821MR4R5A0		820	0.06	4.5	8500	164
SD0E561MR009A0	2.5	560	0.06	9	6300	140
SD0E681MR006A0		680	0.06	6	7500	170
SD0E821MR4R5A0		820	0.06	4.5	8500	205
SD0J331MR012A0	6.3	330	0.06	12	5600	207.9
SD0J471MR009A0		470	0.06	9	6300	296.1
SD1A221MR018A0	10	220	0.06	18	4800	660
SD1A331MR015A0		330	0.06	15	5100	990
SD1B221MR030A0	12.5	220	0.06	30	3500	825
SD1C221MR030A0	16	220	0.06	30	3500	1056
SD1D151MR030A0	20	150	0.06	30	3500	900
SD1E101MR030A0	25	100	0.06	30	3500	750

备注:

\*1: 120Hz, +20±1℃

\*2: 120Hz, +20±1℃

\*3: 100KHz, +20±1℃

\*4: 100KHz, +45±1℃

\*5: 额定电压, 2分钟